

СООБЩЕНИЯ  
ОБЪЕДИНЕННОГО  
ИНСТИТУТА  
ЯДЕРНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДУБНА



C36  
M-317

31/11 - 75  
P14 - 8480

З.Маттхиз

1248/2-75

ОБ ЭНЕРГИЯХ

ЭЛЕКТРОННЫХ МУЛЬТИПЛЕТОВ  $\text{Pr}^{3+}$

В РАЗЛИЧНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

**1974**

ЛАБОРАТОРИЯ НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ

P14 - 8480

З.Матхиз

ОБ ЭНЕРГИЯХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ МУЛЬТИПЛЕТОВ  $\text{Pr}^{3+}$   
В РАЗЛИЧНЫХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Соудорожский институт  
ядерных исследований  
**БИБЛИОТЕКА**

## 1. Введение

Экспериментальному и теоретическому исследованию энергий электронных уровней ионов редкоземельных элементов в различных кристаллических соединениях посвящено большое число работ, и по этим вопросам имеются подробные обзоры /1,2/. Гамильтониан, который определяет энергию этих электронных уровней, обычно представляется в виде

$$H = H_0 + H_{kp}. \quad /1/$$

$H_0$  - гамильтониан свободного иона. Он описывает все взаимодействия валентных электронов в изолированном ионе.  $H_{kp}$  - гамильтониан кристаллического поля.

За счет  $H_0$  происходит расщепление энергий электронных состояний конфигурации  $(4f)^n$  на мультиплеты  $^{2S+1}L_J$ .  $H_0$  сохраняет только полный момент количества движения  $J$ . Полный орбитальный момент количества движения  $L$  и спин  $S$  имеют лишь приближенный характер.  $H_{kp}$  снимает  $(2J+1)$ -кратное энергетическое вырождение мультиплетов по отношению к проекциям  $M_J$  и расщепляет мультиплеты на так называемые кристаллические уровни. Хорошо оправдал себя модельный гамильтониан вида

$$H_{kp} = \sum_{i=1}^n \sum_{\ell,m} A_m^\ell Y_m^\ell (\Omega_i); \quad \ell = 2, 4, 6; \quad m = 0, \pm 1, \dots \pm \ell, \quad /2/$$

где  $Y_m^\ell$  - обычные сферические функции /3/, а  $\Omega_i$  - угловые координаты  $i$ -того валентного электрона,  $A_m^\ell$  - числовые постоянные, которые характеризуют силу и точечную симметрию /не все  $A_m^\ell$  в зависимости от этой симметрии отличны от нуля/ кристаллического поля в месте

нахождения редкоземельного иона. Если бы весь эффект влияния кристаллического окружения редкоземельного иона на энергию его электронных уровней сводился бы только к  $H_{kp}$ , то в рамках первого приближения теории возмущения относительно  $H_{kp}$  центр тяжести энергии кристаллических уровней определенного мультиплета должен был совпадать с энергией того же /нерасщепленного/ мультиплета в случае свободного иона ( $H_{kp} = 0$ ). В действительности это не так. Если ион находится в кристалле, то наблюдается заметное снижение центров тяжести энергий мультиплетов по сравнению со случаем свободного иона /4/. Это снижение нельзя объяснить одними эффектами учета более высоких порядков теории возмущения относительно  $H_{kp}$  /“эффекты второго порядка”/, которые ведут к некоторому смешиванию состояний, принадлежащих мультиплетам с различными  $J$ .

Наличие кристаллического окружения, которое искаивает волновые функции заполненных оболочек, а также основных и возбужденных состояний валентных электронов /конфигурации, отличные от  $(4f)^n$  /, сказываеться, таким образом, эффективно и на  $H_0$ .

В настоящий момент все эти эффекты удается учитывать лишь полуэмпирическим образом. Для этой цели выделяют в матричных элементах  $(H_0)_{ik}$  для различных состояний  $i, k$  конфигурации  $(4f)^n$  радиальные интегралы, приравнивая их к определенным постоянным  $\{B\}$ . Эти постоянные подгоняются под экспериментальные энергии уровней конфигурации  $(4f)^n$ . Подробно все эти вопросы изложены в работах /1,5/.

Конечной целью обычных расчетов является определение параметров  $A_m^l$  из /2/. Поскольку в случае низкой точечной симметрии кристаллического поля число отличных от нуля параметров  $A_m^l$  обычно больше числа кристаллических уровней одного мультиплета, то для однозначного и наиболее последовательного определения параметров  $A_m^l$  желательно использовать экспериментальные значения энергий уровней всех мультиплетов данной конфигурации. При этом автоматически возникает задача определения параметров  $\{B\}$ . Такая программа определения параметров кристаллического поля делится на три этапа:

I. Подгонка параметров  $\{B\}$  гамильтониана свободного иона  $H_0$  по экспериментальным значениям центров тяжести энергий мультиплетов конфигурации  $(4f)^n$ .

II. Подгонка параметров  $A_m^l$  по энергиям кристаллических уровней отдельных мультиплетов относительно центров тяжести энергий последних  $\{B\}$  - не варьируются.

III. Подгонка параметров  $\{B\}$  и  $A_m^l$  по энергиям кристаллических уровней всех мультиплетов относительно основного кристаллического уровня конфигурации - учет эффектов второго порядка.

На практике не всегда удается придерживаться этой программы, т.к. часто экспериментальные данные об энергиях кристаллических уровней конфигурации  $(4f)^n$  недостаточно богаты. В этих случаях необходимо отнести с осторожностью к физической ценности параметров  $A_m^l$  и связанных с ними волновых функций кристаллических уровней, определяемых по упрощенной схеме.

В настоящей работе приведены матрицы  $H_0$  для мультиплетов конфигурации  $(4f)^2$  и результаты подгонки параметров  $\{B\}$  по энергетическим уровням  $Pr^{3+}$  в кристаллах  $LaF_3$ . При проверке разработанной автором для ЭВМ программы определения энергетического положения мультиплетов в зависимости от параметров  $\{B\}$  при помощи сравнения наших результатов с расчетными данными, приведенными в работе /5/, было обнаружено, что в /5/ имеется ряд ошибок, которые влияют на достоверность опубликованных там результатов. Поэтому расчеты работы /5/ были повторены.

## 2. Гамильтониан свободного иона \*

Гамильтониан свободного иона состоит из ряда членов, которые описывают различные взаимодействия; наиболее важными из них являются следующие:

$$H_N, H_e, H_{SO}, H_{CI}, H_{OO}, H_{S00}, H_{SS}^{/5-7/}.$$

\* В дальнейшем мы ограничиваемся частным случаем конфигурации  $(4f)^2$ .

$H_N$  содержит центральное кулоновское поле ядра, действующее на валентные электроны и частично экранированное заполненными оболочками ионного остова. Учет одного  $H_N$  дает нулевое приближение решения задачи об определении энергий электронных уровней, которое считается известным.

a/  $H_e$  - кулоновское взаимодействие валентных электронов между собой:

$$H_e = \frac{e^2}{r_{12}}. \quad /3/$$

Матричные элементы  $H_e$  по отношению к антисимметризованным волновым функциям  $| (4f)^2, L, S, J, M_J \rangle$  с полным орбитальным моментом количества движения  $L$ , полным спином  $S$ , полным моментом количества движения  $J$  и его проекцией  $M_J$  можно представить в виде  $/7/$ :

$$\begin{aligned} & \langle (4f)^2, L, S, J, M_J | H_e | (4f)^2, L', S', J', M'_J \rangle = \\ & = \delta_{JJ'} \delta_{M_J M'_{J'}} \delta_{LL'} \delta_{SS'} \sum_{k=0,2,4,6} f_k F^k, \quad /4/ \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} f_K &= (-1)^L (3||C^K||3)^2 W(3,3,3,3; L, K), \quad (3||C^K||3) = \\ &= -7 \begin{pmatrix} 3 & K & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ и } F^K = F^K(4f, 4f) = \\ &= e^2 \int \frac{r^K}{r_{K+1}} R_{4f}^2(r_1) R_{4f}^2(r_2) r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2 - \end{aligned}$$

так называемые слэтеровские интегралы по радиальным функциям  $(4f)$  - электронов  $R_{4f}$ . Мы пользуемся перенормированными Кондоном и Шортли  $/8/$   $F_K$ :

$$F_0 = F^0, F_2 = \frac{1}{(15)^2} F^2, \quad F_4 = \frac{1}{(3 \cdot 11)^2} F^4 \text{ и } F_6 = \left[ \frac{5}{3 \cdot 11 \cdot 13} \right]^2 F^6.$$

Таблица I  
Зависимость матрицы  $(L, S, J || H_0 || L', S', J)$  - см. /9/ -  
от параметров  $\{8\}$ . Правило расположения коэффициентов  
см. на примере матричного элемента  $(3P_0 || H_0 || 1S_0)$ .

${}^3P_1$	${}^3P_2$	${}^3P_3$
${}^3S_1$	${}^1S_0$	${}^1S_0$
${}^3P_0$	${}^3P_1$	${}^3P_2$
${}^3D_1$	${}^3D_2$	${}^3D_3$
${}^1D_2$	${}^1D_3$	${}^1D_4$
${}^3F_2$	${}^3F_3$	${}^3F_4$
${}^1F_2$	${}^1F_3$	${}^1F_4$
${}^3P_1$	${}^3P_2$	${}^3P_3$
${}^3D_1$	${}^3D_2$	${}^3D_3$
${}^1D_2$	${}^1D_3$	${}^1D_4$
${}^3F_2$	${}^3F_3$	${}^3F_4$
${}^1F_2$	${}^1F_3$	${}^1F_4$

Матричные элементы /4/, вновь рассчитанные по этим формулам /см. табл. 1/, совпадают с ранее опубликованными /2,9/.

При подгонке параметров  $F_K$  члены с  $F_0$  в матричных элементах можно опускать, поскольку они дают одинаковый вклад в энергию всех мультиплетов. Таким же образом мы поступаем с аналогичными членами, которые встречаются ниже.

#### 6/ $H_{S0}$ - спин-орбитальное взаимодействие

Это взаимодействие имеет вид

$$H_{S0} = \sum_{i=1,2} a(r_i) \vec{\ell}_i \cdot \vec{S}_i. \quad /5/$$

При помощи соотношения  $\xi_{4f} = \int a(r) R_{4f}^2(r) r^2 dr$  матричные элементы оператора /5/ параметризуются следующим образом /7,10/:

$$\begin{aligned} & \langle (4f)^2, L, S, J, M_J | H_{S0} | (4f), L', S', J', M_J' \rangle = -\delta_{JJ'} \delta_{M_J M_J'} \xi_{4f} \times \\ & \times \sqrt{7 \cdot 8 \cdot 9} \sqrt{(2L+1)(2L'+1)(2S+1)(2S'+1)} W(J, L, S', 1; S, L') \times \\ & \times W(1/2, S, 1/2, 1; 1/2, S') W(3, L, 3, 1; 3, L'). \end{aligned} \quad /6/$$

Матрицы /6/ для мультиплетов конфигурации  $(4f)^2$  /см. табл. 1/ в явном виде опубликованы /2,11/. При использовании этих матриц необходима, однако, определенная осторожность. При сравнении коэффициентов, стоящих перед  $\xi_{4f}$  в матричных элементах ( ${}^1D_2 | H_{S0} | {}^3P_2$ ), ( ${}^3P_0 | H_{S0} | {}^1S_0$ ), ( ${}^3H_4 | H_{S0} | {}^1G_4$ ), которые указаны в работах /2,11/, с коэффициентами, приведенными в табл. 1, видно, что они отличаются знаками. Это объясняется различным выбором фаз для волновых функций отдельных мультиплетов. Если энергии центров тяжести мультиплетов подгоняются только при помощи четырех параметров,  $F_2$ ,  $F_4$ ,  $F_6$  и  $\xi_{4f}$ , то это отличие несущественно. Если учитываются наряду с  $H_e$  и  $H_{S0}$  также ниже-

описанные взаимодействия, то необходимо использовать всегда один и тот же выбор фаз.

#### в/ $H_{CI}$ - конфигурационное взаимодействие

$H_{CI}$  учитывает во втором приближении теории возмущения кулоновское взаимодействие  $e^2/r_{12}$  между валентными электронами /1,12/. Вклад этого приближения в энергию мультиплетов дается выражением типа

$$-\sum_{\tau} \langle (4f)^2, L, S, J, M_J | H_e | \psi_{\tau} \rangle \langle \psi_{\tau} | H_e | (4f)^2, L', S', J', M_J' \rangle /E_{\tau}, \quad /7/$$

где  $\psi_{\tau}$  - волновая функция двухэлектронного состояния энергетически более высокой конфигурации ( $\tau$ ) /например,  $(5d)^2$  или  $(4f, 6p)$  с энергией  $E_{\tau}$ /. Соотношение /7/ можно представить как матричный элемент некоторого эффективного оператора  $H_{CI} = H_{CI} + H'_{CI}$ , действующего на состояния конфигурации  $(4f)^2$ . Матричные элементы  $\langle (4f)^2, L, S, J, M_J | H'_{CI} | (4f)^2, L', S', J', M_J' \rangle$  отличаются от /4/ лишь видом радиальных интегралов. Подгоняя при помощи параметров  $F_K$  теоретические положения мультиплетов к экспериментальным, мы тем самым учитываем наряду с  $H_e$  также и  $H'_{CI}$ , т.е. при этом происходит некоторое экранирование (screening) истинных значений слэтеровских интегралов. Матричные элементы второй части  $H_{CI} \langle (4f)^2, L, S, J, M_J | H'_{CI} | (4f)^2, L', S', J', M_J' \rangle$  не сводятся к соотношениям типа /4/ и принимают вид /1/:

$$\delta_{LL} \delta_{SS'} \delta_{JJ'} \delta_{M_J M_J'} [a(L+1)L + \beta G(G_2) + \gamma G(R_7)], \quad /8/$$

где  $a$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  - выражения, состоящие из радиальных интегралов, в которые входят функции  $R_{4f}$ ,  $R_7$  и энергии  $E_{\tau}$ .  $a$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  используются при полуэмпирическом подходе как подгоночные параметры.  $G(G_2)$  и  $G(R_7)$ \* для мультиплетов конфигурации  $(4f)^2$  приведены в /1/.

\*  $G(G_2)$  и  $G(R_7)$  являются собственными значениями оператора Казимира /9/.

### г/ $H_{00}$ - орбит-орбитальное взаимодействие

$H_{00}$  описывает взаимодействие между магнитными моментами орбитального движения валентных электронов и определяется выражением /в атомных единицах//1/:

$$H_{00} = \frac{a_0^2}{2} \left[ \frac{1}{r_{12}} (\vec{\nabla}_1 \cdot \vec{\nabla}_2) + \frac{1}{r_{12}^3} \{(\vec{r}_{12} \cdot \vec{\nabla}_1)(\vec{r}_{12} \cdot \vec{\nabla}_2) + \right.$$

$$\left. + (\vec{r}_{21} \cdot \vec{\nabla}_2)(\vec{r}_{21} \cdot \vec{\nabla}_1) + \frac{1}{r_{12}^2} (\vec{r}_{12} \cdot \{ \vec{\nabla}_1 - \vec{\nabla}_2 \}) \right],$$

где  $a_0 = e^2/hc$  – постоянная тонкой структуры.

Матричные элементы  $\langle (4f)^2, L, S, J, M_J | H_{00} | (4f)^2, L', S', J', M'_J \rangle$  можно свести к форме /8//13/. В возникающие при этом выражения, заменяющие  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , в дополнительный постоянный член  $2\omega$ , не зависящий от  $L$ ,  $S$ ,  $J$  и  $M_J$ , входят интегралы Марвина /14/:

$$M^k = \iint_{r_1 < r_2} R_{4f}^2(r_1) R_{4f}^2(r_2) \frac{r_1^k}{r_2^{k+3}} dr_1 dr_2.$$

### д/ $H_{S00}$ - взаимодействие спин-чужая орбита (spin-other orbital interaction)

Матричные элементы оператора этого взаимодействия /15/:

$H_{S00} = \frac{a_0^2}{2} \{ [\vec{\nabla}_1 (\frac{1}{r_{12}}) \times \vec{\nabla}_1] \cdot (\vec{S}_1 + 2\vec{S}_2) + [\vec{\nabla}_2 (\frac{1}{r_{21}}) \times \vec{\nabla}_2] \cdot (\vec{S}_2 + 2\vec{S}_1) \},$  также распадаются на две части. Зависимость первой части от  $L$ ,  $S$ ,  $J$ ,  $M_J$  совпадает с той, которая встречается в выражении /6/. Матричные элементы второй части исследованы в работах /15, 16/ и содержат интегралы  $M^k$ .

### е/ $H_{ss}$ - спин-спиновое взаимодействие

$$H_{ss} = a_0^2 \left[ \frac{(\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2)}{r_{12}^3} - \frac{3(\vec{r}_{12} \cdot \vec{S}_1)(\vec{r}_{12} \cdot \vec{S}_2)}{r_{12}^5} \right]$$

имеет матричные элементы, радиальные интегралы которых опять сводятся к  $M^k$  /15, 16/.

Если ограничиваться перечисленными взаимодействиями и рассматривать радиальные интегралы, входящие в матричные элементы гамильтониана свободного иона

$$\langle (4f)^2, L, S, J, M_J | H_0 | (4f)^2, L', S', J', M'_J \rangle = \langle L, S, J | H_0 | L', S', J' \rangle \delta_{M_J M'_J} / 9/$$

как свободные параметры подгонки, то набор  $\{B\}$  будет состоять из 10 параметров:

$$F_2, F_4, F_6, a, \beta, \gamma, \zeta_{4f}, M^0, M^2, M^4. /10/$$

Хорошие результаты учета "магнитных" взаимодействий дает приближение  $M^0 = M^2 = M^4$  /16/. Таким образом, число свободных параметров снижается до восьми /  $F_2, F_4, F_6, \zeta_{4f}, a, \beta, \gamma, M^0$  /. Матричные элементы  $\langle L, S, J | H_0 | L', S', J' \rangle$  для всех мультиплетов конфигурации  $(4f)^2 / ^1S_0, ^3P_0, ^3P_1, ^3P_2, ^1D_2, ^3F_2, ^3F_3, ^3F_4, ^1G_4, ^3H_4, ^3H_5, ^3H_6, ^1I_6 /$  в зависимости от этих параметров приведены в табл. 1.

### 3. Результаты определения параметров гамильтониана свободного иона

В работе /5/ приведены результаты определения параметров гамильтониана свободного иона для  $Pr^{3+}$ , находящегося как в свободном состоянии, так и в целом ряде кристаллических соединений ( $Pr: LaF_3, Pr(NO_3)_3 \cdot 6H_2O, Pr[C_2H_5(SO_4)]_3 \cdot 9H_2O, PrCl_3, Pr: LaCl_3, Pr: LaBr_3$ ). Расчеты велись для двух наборов  $\{B\}$ :

$$\{4\} = F_2, F_4, F_6, \zeta_{4f} \quad \text{и} \quad \{8\} = \{4\}, a, \beta, \gamma, M^0 (M^0 = M^2 = M^4).$$

При решении задачи определения параметров  $A_m^\ell$  для  $Pr: LaF_3$  по описанной во введении схеме автору настоящей работы потребовались матрицы, приведенные в табл. 1. Поскольку они в таком виде ранее не публи-

ковались, матрицы были восстановлены по общим формулам, указанным в предыдущем параграфе. С целью проверки матриц сравнивались значения энергий мультиплетов, приведенные в <sup>5/</sup>, со значениями, получающимися после диагонализации матриц, с учетом численных значений параметров {B} из <sup>5/</sup>. При этом было обнаружено, что в <sup>5/</sup> содержатся ошибки, которые коротко обсуждаются ниже.

#### a/ Набор {4}

В табл. 2 сравниваются данные, приведенные в <sup>5/</sup> для спектра свободного иона  $\text{Pr}^{3+}$ , с энергиями мультиплетов, получающимися с {4} из <sup>5/</sup> при помощи матриц табл. 1. Видно, что в пределах расчетной точности для большинства мультиплетов значения энергий хорошо совпадают друг с другом\*. С другой стороны, обнаружилось /см. метки: \*, +, !/, что некоторые "адреса" мультиплетов в <sup>5/</sup> перепутаны:  $^1\text{I}_6$ ,  $^3\text{P}_0$ ,  $^3\text{P}_1$  следует читать соответственно как  $^3\text{P}_1$ ,  $^1\text{I}_6$  и  $^3\text{P}_0$ . В остальных спектрах табл. IV <sup>5/</sup> перепутаны мультиплеты  $^3\text{P}_1$  и  $^1\text{I}_6$ . Ясно, что такая ситуация влияет на результаты подгонки. Автором были повторены расчеты {4} для всех спектров, приведенных в табл. IV <sup>5/</sup>. В табл. 2 содержатся результаты подгонки для случая свободного иона  $\text{Pr}^{3+}$ . Видно, что набор {4}, соответствующий минимуму среднего квадратичного отклонения экспериментальных от "теоретических" энергий мультиплетов с "правильными" адресами, не очень сильно отличается от приведенного в <sup>5/</sup> набора {4}. Это справедливо и для остальных спектров. Конечные значения средних линейных отклонений по найденным новым наборам {4} всюду несколько /максимально на фактор 2 при  $\text{Pr:LaF}_3$  и

\* Расчеты велись на CDC1604A; для диагонализации матриц использовалась программа KIM <sup>17/</sup>. Точность собственных значений:  $\epsilon^2$ ;  $\epsilon$  бралось равным 0,00005.

**Таблица 2**  
Численные значения параметров {4} гамильтониана № и положения мультиплетов свободного иона  $\text{Pr}^{3+}$ /все в  $\text{см}^{-1}$ / . А - экспериментальный спектр <sup>22/</sup>; В - результаты расчетов работы <sup>5/</sup>; С - энергии мультиплетов, выходящие из матриц табл. 1 с использованием {4} из <sup>5/</sup>; Д - результаты расчетов настоящей работы,  $\Delta$  - среднее линейное отклонение от экспериментального спектра.

	A	B	C	D
$F_2$		315,94	315,94	316,201
$F_4$		49,39	49,39	48,1397
$F_6$		4,77	4,77	4,93911
$F_{4f}$		748,14	748,14	775,614
$^1S_0$	50 090,3	50 106,7	50 105,8	50 225,3
$^3P_2$	23 160,6	23 461,1	23 462,6	23 345,3
$^1I_6$	22 211,5	22 279,1*	21 343,8!	21 389,9
$^3P_1$	22 007,5	21 666,9 <sup>+</sup>	22 280,8*	22 066,4
$^3P_0$	21 389,8	21 343,5!	21 668,5 <sup>+</sup>	21 425,7
$^1D_2$	17 334,4	17 310,1	17 309,6	17 549,3
$^1G_4$	9 921,2	9 872,8	9 873,0	9 916,3
$^3F_4$	6 854,8	6 896,3	6 896,6	6 881,1
$^3F_3$	6 415,2	6 418,7	6 419,1	6 442,2
$^3F_2$	4 996,6	5 023,7	5 024,0	4 992,8
$^3H_6$	4 389,1	4 288,3	4 288,3	4 454,4
$^3H_5$	2 152,1	2 093,2	2 093,2	2 181,0
$^3H_4$	0,0	0,0	0,0	0,0
$\Delta$			170,3	133,9

$\text{Pr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  / улучшаются по сравнению с <sup>5/</sup>. В том случае, когда известны /см. ниже/ наборы {8}, наборы {4} имеют лишь качественное значение, и поэтому мы их для других перечисленных спектров в настоящей работе не выписываем.

## 6/ Набор {8}

При сравнении полученных при помощи матриц табл. 1 энергий мультиплетов, относящихся к наборам {8} из табл. III/5/, с приведенными в табл. II/5/ энергиями, было отмечено следующее: для большинства спектров сравниваемые величины хорошо совпадают друг с другом. В некоторых случаях встречаются небольшие отличия в положениях отдельных мультиплетов /максимально на  $26 \text{ см}^{-1}$ / . Эти отличия связаны с округлением при публикации в /5/ численных значений параметров {8}, полученных в результате подгонки. В спектрах  $\text{Pr:LaF}_3$  (CRB) и  $\text{Pr:LaF}_3$  (CFS) опять перепутаны адреса мультиплетов. В первом случае вместо  ${}^3\text{P}_0$  /или  ${}^3\text{P}_1$ / и  ${}^1\text{I}_6$  следует читать  ${}^3\text{P}_0$  /или  ${}^1\text{I}_6$ / и  ${}^3\text{P}_1$ . Во втором спектре перепутаны мультиплеты  ${}^3\text{P}_1$  и  ${}^1\text{I}_6$ . В наборе {8} для  $\text{PrCl}_3$  в /5/ содержится, наверное, опечатка, поскольку приведенный там набор совершенно не воспроизводит публикуемый спектр.

Автором настоящей статьи была вновь проделана подгонка параметров {8} для всех приведенных в табл. III/5/ спектров. В результате расчетов для спектров  $\text{Pr}^{3+}$  /свободный ион/,  $\text{Pr:LaF}_3$  (CRB /18/),  $\text{Pr:LaF}_3$  / CFS /19/ - без  ${}^3\text{H}_5$  /,  $\text{Pr:LaF}_3$  (WSJ/4/),  $\text{Pr:LaCl}_3$ ,  $\text{Pr:LaBr}_3$  были получены наборы {8}, которые практически совпадают с публикуемыми в /5/. В случае спектра  $\text{Pr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  набор {8} несколько отличается от найденного автором /в скобках значения из /5/;  $\Delta$  - среднее линейное отклонение теоретического от экспериментального спектра; все в  $\text{см}^{-1}$  /: 317,062 /315, 44/; 50,8039 /51, 17/; 5,11551 /5, 19/; 735,584 /741, 12/; 24,6394 /18, 76/; -910,520 /-756, 77/; 458,896 /88, 05/; 0,149698 /0, 432/;  $\Delta = 25,3$  /27,30/.

Полученный для  $\text{Pr}[\text{C}_2\text{H}_5(\text{SO}_4)]_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$  набор {8} хотя и отличается слегка от приведенного в /5/, однако он представляет мало интереса, поскольку подгонка восьми параметров производится только по восьми мультиплетам. Среднее линейное отклонение принимает в этом случае очень маленькие значения, и окончательный набор {8} зависит от момента прекращения процесса подгонки.

Полученный набор {8} для  $\text{PrCl}_3$  следующий: 322,365; 56,4509; 6,16997; 754,716; 23,6692; -722,383; -2232,08; 1,17603;  $\Delta = 9,33$ . Ценность этого набора параметров, наверное, также мала, поскольку отсутствуют данные о положении мультиплета  ${}^1\text{S}_0$ . Вытекающее из приведенного набора {8} положение  $57039 \text{ см}^{-1}$  слишком высокое.

С целью подготовки программы определения параметров кристаллического поля  $A_m^l$  для  $\text{Pr:LaF}_3$  были заново проанализированы экспериментальные спектры /4, 18, 19/. В отличие от спектра "CFS" /5/ для определения {8} учитывался наряду с мультиплетом  ${}^3\text{H}_5$  еще один кристаллический уровень из мультиплета  ${}^3\text{H}_6$  при  $4219 \text{ см}^{-1}$  /18/. С учетом этого уровня положение центра тяжести мультиплета  ${}^3\text{H}_6$  составляет тогда  $4466 \text{ см}^{-1}$ . Результаты определения параметров {8} указаны в табл. 3(В). Волновые функции, соответствующие этим параметрам, приведены ниже:

$$\begin{aligned}
 |{}^3\text{P}_0\rangle &= 0,99497|{}^3\text{P}_0\rangle + 0,10014|{}^1\text{S}_0\rangle \\
 |{}^1\text{S}_0\rangle &= -0,10014|{}^3\text{P}_0\rangle + 0,99497|{}^1\text{S}_0\rangle \\
 |{}^3\text{F}_2\rangle &= 0,98822|{}^3\text{F}_2\rangle + 0,15242|{}^1\text{D}_2\rangle - 0,01410|{}^3\text{P}_2\rangle \\
 |{}^1\text{D}_2\rangle &= -0,14996|{}^3\text{F}_2\rangle + 0,94556|{}^1\text{D}_2\rangle - 0,28884|{}^3\text{P}_2\rangle \\
 |{}^3\text{P}_2\rangle &= -0,03069|{}^3\text{F}_2\rangle + 0,28755|{}^1\text{D}_2\rangle + 0,95727|{}^3\text{P}_2\rangle \\
 |{}^3\text{H}_4\rangle &= 0,98612|{}^3\text{H}_4\rangle + 0,16337|{}^1\text{G}_4\rangle - 0,02966|{}^3\text{F}_4\rangle \\
 |{}^1\text{G}_4\rangle &= -0,11374|{}^3\text{H}_4\rangle + 0,79478|{}^1\text{G}_4\rangle + 0,59614|{}^3\text{F}_4\rangle \\
 |{}^3\text{F}_4\rangle &= 0,12097|{}^3\text{H}_4\rangle - 0,58449|{}^1\text{G}_4\rangle + 0,80233|{}^3\text{F}_4\rangle \\
 |{}^1\text{I}_6\rangle &= 0,99853|{}^1\text{I}_6\rangle + 0,05415|{}^3\text{H}_6\rangle \\
 |{}^3\text{I}_6\rangle &= -0,05415|{}^1\text{I}_6\rangle + 0,99853|{}^3\text{H}_6\rangle .
 \end{aligned}$$

В табл. 3 /С/ приведены также набор {8} и положения центров тяжести мультиплетов, которые были получены в результате определения параметров  $A_m^l$  по полной программе /этапы I, II, III, см. введение/ с учетом эффектов второго порядка /20/.

**Д10-7707** Совещание по программированию и 564 стр. 5 р. 57 к.  
математическим методам решения  
физических задач, Дубна, 1973.

**13 - 7154** Пропорциональные камеры. Дубна, 173 стр. 2 р. 20 к.  
1973.

**Д1,2-7781** Материалы III Международного сим- 478 стр. 4 р. 78 к.  
позиума по физике высоких энергий  
и элементарных частиц. Синай, 1973.

**Д3-7991** II Международная школа по нейт- 552 стр. 2 р. 50 к.  
ронной физике. Алушта, 1974.

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу:

101000 Москва, Главпочтamt, п/я 79,  
издательский отдел Объединенного института ядерных исследований.